# **ENZYME SENSOR**

Publication number: JP62144062 Publication date: 1987-06-27

Inventor:

KARUBE MASAO; KUBO IZUMI

**Applicant:** 

**FUJI ELECTRIC CO LTD** 

Classification:

- international:

G01N27/414; G01N27/30; G01N27/403; G01N27/30;

(IPC1-7): G01N27/30

- European:

Application number: JP19850285308 19851218 Priority number(s): JP19850285308 19851218

Report a data error here

# Abstract of JP62144062

PURPOSE:To suppress the permeation of cation other than ammonia without use of a reference electrode, by providing an ammonia selectively permeating film between an si3N4 film covered with an ion sensitive FET and an enzyme immobilized membrane. CONSTITUTION:A hydrophobic Si3N4 protective film 8 is formed on an SiO2 film 7 covering a gate section 6 of an ion sensitive FET10. A sample aqueous solution immersed portion of the film 8 is provided with an ammonia selectively permeating film 20 comprising a polymer such as poly-gamma-trichloro ethyl glutamate and an non-actin having ammonia selective permeating property. An enzyme immmobilized membrane 30 is applied covering the film 20. With such an arrangement, H<+>, Na<+>, K<+> and the like in the sample aqueous solution is suppressed in the permeation with the membrane 20 and ammonia which was generated from an enzyme reaction with the membrane 30 premeates selectively to change the gate potential. This can eliminate any reference electrode thereby simplyfying the equipment.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

愈日本國特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

# ®公開特許公報(A)

昭62-144062

@Int.Cl.4

識別配号

厅内整理番号

@公開 昭和62年(1987)6月27日

G 01 N 27/30

J - 7363-2G F - 7363-2G

水蕊未 発明の数 1 (全4頁) 審査請求

酵業センサー の発明の名称

> 頤 昭60-285308 ②特

昭60(1985)12月18日 御出

砂発明 考 密 征 央

立川市富士見町 4 - 11 - 8

いづみ 砂発 明 者 久保 富士電機株式会社 の出願 人

川岭市川岭区田辺新田 1 番 1 号 富士電機株式会社内

川崎市川崎区田辺新田1番1号

弁理士 山口 ②代理人

- 5、 強列の名称 軽素をンサー
- 特許請求の範囲

1)ゲート総を合む弟子の表面部分が現水性を有す も建化器業保護限により覆われたイオン感受性電 異筋異型トランジスタと、このイオン感受性需要 効果型トランジスタの盛化硅素保護膜の供は水溶 彼後機能分を覆りよう放着されたアンチニア選択 透過性限と、このアンモニア選択適過性額を買う よう破者をれた健衆固定化膜とを消えたことを執 徴とする酢煮センサー。

2)特許請求の範囲第1項記載のものにおいて、ア ンモチア選択透過性膜が膜を形成するポリマーと アンモデス選択透過能を有するノナクチンとから はることを特徴とする解案センリー。

3)終終請求の範囲第1項記載のものにおいて、ポ リマーがポリーエートリクロウエチルグルクメー トであることを答改とする部者センター。

3. 免明の終細な段別

【范明の属する技術分詞】

本発明は、イオン感受性健身効果製トランジス タ (以下しSFETと略称する) を用いた酵素も ンチャ、ことに供試水溶液中の尿素の定量に使用 される酵素センサーに関する。

【徒乗技術とその問題点】

ISFBTを信号変換盤に利用したパイオセン サーとしては、1980年によ、Janasa のによって免 表されたペニシリンを数理するためのベニシリン センサーをはじめとして、尿器センサー、グルコ ースセンサーなどが知られている。これらはいず れも18881の表面に形成された分子限別部で ある酵素固定化膜で有機物が分解されることによ って生じるpx数化を、信号契換値である1SPE でで電機信号に変換して認定する方式のものであ り、センサーを小形かつ高感度化できる別点が導 られる。しかしながら、この猫のセンサーにおい ては供収水溶液中に酵幣反応以外の原因でじょ。 Kar. K·毎のカチオンなどのイオン海皮変化や 111の変化があると、額定に調整を生するという間 題がおり、この影響を排除するために1SPBで

# 特丽昭 62-144062 (2)

## 「発別の目的」

本発明は前述の状況に最みてなされたもので、 参照費権を用いることなくアンモニア以外のカチオンの影響を体験することができ、 したかって供 以水溶液中の原発の関連検索が高く、 簡素化され て 実施な酵素センサーを提供しようとするもので ある。

### 【発明の要点】

本発明は、ゲート部を含むPBTの液面を酸化 健保(Si Gi) 物解説および変化腫素(Si i N a)深度 設で破視して耐水性を保持した(SFBTの表面 も、狭を形成するボリマーとアンモニア政民透過

男 1 図は本発明の実施例を示す解末センサーの 側が即回である。図において、10はイオン型受性 電界効果型トランジスタ(1 S F & T)でありイン しは P - S(技版、2 はソース理様、3 は F レレット で伝、4 は A 振微鏡 域、5 は P チャネルストッパ ー、6 は金銭電極が那麼されたゲート部の表された ナト部6を含む F B T 表面を限りよう B 成本 たたた 510. 地接額、8 は Sio. 競機を の外側に 形成を れた 型化館象(8ista) 伝統機 であり、 供飲 で たた 後週 きれる 部分を 密化 健素保護 で で で さる。

20はアンセニア選択透過性膜であり、酸を形成するボリマーと、アンモニア選択透過能を有する抗生物質ノナクチンからなる。ノナクチンは低が多く性限しており、四階から公知の方法で消化が多く性限しており、四階から公用しておいない。イセス・グリセクス社製の市販品を用いてもよい。アンモニア選択透過性慢を影破するポリマーとしては、拡ポリマーから形成される酸がプロトンを

誰をなずる抗生物質ノナクランからなるアンモニ ア選択透過效威、ならびにこのアンモニア選択遺 通性膜の外側に形成された卵素反応の悲愛または 生成数にアンモニアが関与する性質を有する群構 を固定化した酵素固定化酸で二度に放復するよう 構成した。アンモニア選択透過技蔵中のノナクチ ンは、皇体中では意体膜に結合して1個カチオン の透過を選択的に行なうイオノフェアであり、カ テォンに対する観和性は 80.4° > K ° » #o ° で特 にアンモニアをよく透過させる。したがって、供 試水溶粧中の目・、Na\* , X \* などのカチオンは アンモニア選択透過性額によりその透過が阻止さ れ、これらのカチオンに答づくISPETのゲー F 電域の変化を関止できるとともに、酵素気息に より生じたアンモニアを選択的に透過することに より、俄然水物液中のアンモニア基別。 'による ゲート電位の変化をドレーン電流の変化として感 度よく測定することができる。

## 【発明の実施物】

以下本発明を実施例に基づいて説明する。

透過させず、かつノナクチンの良曜様であるチト ラヒドロフラン(THP)に易得である必要があ る。このような条件を満たすポリマーとしてポリ メチルグルタメート誘導体、ポリ塩化ビニリデン、 アセチルセルローズ及びその誘導体などがある。 これらのポリマーとノナクテンを有機溶媒に陰解 させてポリマードーブを祭、このポリスードーブ から薄穀を形成させる。しSFETの表面に罹患 を形成するには、ディップコーティング法による。 1 SFETはポリマーとの接着権を良くするため 適当な炎酸処理を終して用いてもよい。処理の背 類にかかわらず、18P2Tを返棄な過度のポリ マードープに投始し、引き上げた後返輩な方法で 姓級させて強限を形成させる。この際、ISFB 十のゲート部分だけでなく、使用時に供収末熔液 に挿入される部分が安全に接程されるようにアン モニア選択透過性限20を形成させる。

30は、インモニア選択透過性酸20の上に影成された酵素調整化酸であり、固定化する酵素は、酵素反応の基質さたは複点物にアンモニアが関与す

# 特開昭62~144062 (3)

もものであればセンサーとして有効である。この ような母素としては、例えばウレアーゼ、クレア チェンディミナーゼ、グルタミン酸オキンダーゼ などがある。酵素の固定化は公気の方法でかかで 設合形成である方法であればどのような方法でか よい。例えば、ボリビニルアルコールやは治固定 おい、アルブミン、キトサンなどを包含しても は、またはこれらの複合法により、解析を といるない。のでは、まりの複合法により、解析を は代でもる。酵素のの複合法で13P2では できることによって、酵素センサーが得られる。

女箍 的 i

C V D 校により 整化 花 密 様 級 数 8 が 形 成 さ れ た 1 S P B T 10 の 数 面 を 、 r ー ア ミ ノ ブ ロ ピ ル ト リ エ ト キ シ ラン (r ー A P T E S ) を 80 で 。 0.5 u B 5 の 条件 下 で 2 時 間 悪 着 し 。 100 で 2 分 間 加 熱 絡 煙 す る 表 断 処 速 を 行 な っ た 砕 、 ポ リ ー r ー メ チ ル ー レ ー グ ル タ メ ー ト の 読 急 体 で る る ポ リ ー r ー ト リ ク ロ ロ エ テ ル グ ル タ メ ー ト を ポ リ マ ー と す る ア

することにより、 等 1 脚に示すような尿素例定用 の群者センサーを得た。

第2回は前述の実施例になる群繁センサーの原 雲に対する応答特殊線図であり、 医中核曲は尿素 (CO(NIIa) 1) を含む批料液を30℃に保たれた酵素 センサー容器に注入する前後の時間を、疑幅はし SPETのドレーン電波の変化をゲート部6のゲ - ト電位に換算して来したものである。 頤におい て、試料液理入時点(しゃり)以前における電位 E。はJSFET10の強化磁素保護膜8ムアンモ ニア選択透過性膜20との非菌における電気二度語 に基づく界面電位であり、尿素を含む試料液が形 人され、酵素圏定化設30による酵素皮応によって 従業が分類されてアンモニア花(NBC) が発生す る、発生したアンモニア経はアンモニア選択透過 作限26を透過して製化磁素級複類をの発頭に関連 し、雰頭電粒を、や変化させることにより、弱を 図に示すようにゲート福設は立上がり、約2分後 には試料液中の尿素温度に根応した定常状態に到 追する。したがって尿器煙度の異なる銃製機を用

ンモュア選択透惑性質20を形成した。ポリードニ トリクロコエチルグルタメートは、ポリーエーメ チルーモーグルタノートのメチル基をPBOIト **リクロルエタノールでスステル交換し、交換率70** %となったものを用いた。彼ポリマー 100ae及び ストレプトマイセス・グリセカス社製のノテクテ ン2mmをチトラヒドロフラン(THF)しせに溶 話してポリマードーブを得た。上記の方法です。 APTRS処理したISFBTをこのポリマード ープに接頭した後、ゆっくりと引き上げてディッ プレ、16mBeの圧力下、宝器で乾燥し、アンモニ ア選択透過性数20を過激した。また酵素固定化器 30としては、牛虫様アルブミン15me及びカレアー ゼ10mgを3.01M。p#% 0 のリン敬環街級 1 nt に接 別させ、グルタルマルデヒド(G A)をしおにな るように抵加して無難した後、ただちにアンモュ ア道収透過性数2Gが形成された1SFETをこの 殺にディップコッチィングし、デシケッター中。 5℃で乾燥させるという方位で形成され、さらに 0.01 M .?ris·HCl. pm 7.0 四级街波中で十分快度

いてゲート電位あるいはドレーン電流との諮問性 をあらかじめ校正しておけば、此料液中の成業機 度を定量的に過度することができる。

または科液中に R・、Bit・、 X・ 第のカチオンが存在した場合、これらのカテオンはアンモニア 選択透過性数 20により ISFB で 10の 芝化健常保護 B の界面に近づくことが限止されるので、ゲート電位に変化を与えることはなく、したがって 多照 軽級を用いることなく アンモニア以外のカチオンの影響を排除できる 最常 改定預防 布センサーをあることができる。

变路例 2

7 - A P T E S による表面処理を超した i S F E T 力表面に同述の実施倒と同様な超級の f リマードープを用いて 2 圏のディップコーティングを行ねってアンモニア選択透過性膜を形成し、 これにエテレンジア 4 ン 0.1 単名0でで無者し、 たらにグルタルアルデヒド (C A) 0.1 M Y ン数数の後にお

# **犲開昭 62-144062 (4)**

解した後、GAをGSおになるように添加し資料 この彼に上記の処理を施したりSFETを し、5 セマー日韓級して郡衆固定化敗を れをさらに C. O! M Tris - Rol. p# 7. 0 の 環領収で 8 時間洗浄して、尿器避定用の辞罪セン

# 【免明の効果】

44. 数位组

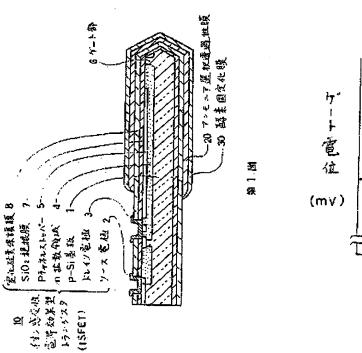
(ISFET)

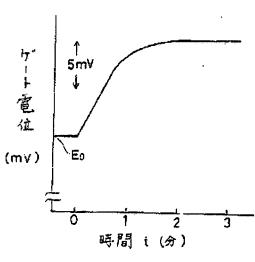
された「SFETのゲート部を合む表面にアンモ

脸されたことによう、健来技術において上記ィオ 撃を打消すために落いられていた参謀電極 をISF名での出力徴号から去し引くため

第「図は太発明の実施例を示す辞票さ

、20:アンモニア選択透過旋殺、





第2図